

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN**  
**CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ**  
**Mã hồ sơ: .....**



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: )

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Quang học

**A. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- Họ và tên người đăng ký: **Trần Việt Cường**
- Ngày tháng năm sinh: 12/03/1977; Nam ; Nữ  ; Quốc tịch: Việt nam;  
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:
- Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Hoài Đức, Hà Tây, Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): 536/11D, Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Căn hộ VP.03.19, Everrich Infinity-Phát Đạt, 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại nhà riêng: .....; Điện thoại di động: 0775120377;  
E-mail: tvcuong@ntt.edu.vn
- Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):  
Từ năm 2008 đến năm 2017: Giảng viên Bộ môn Vật lý Chất rắn, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG Hồ Chí Minh  
Từ năm 2018 đến nay: Giảng viên, chuyên viên nghiên cứu kiêm quản lý tại Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Tp. Hồ Chí Minh  
Chức vụ hiện nay: Phó viện trưởng Viện Kỹ thuật Công nghệ cao kiêm Giám đốc trung tâm VKTech; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó viện trưởng

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: 298-300A, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: (028) 3941 1189; (028) 3940 5875

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): .....

8. Đã nghỉ hưu từ tháng .....năm .....

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): .....

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): .....

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 15 tháng 09 năm 1999; số văn bằng: B151909; ngành: Vật lý; chuyên ngành: Hải dương;

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.

- Được cấp bằng ThS ngày 22 tháng 08 năm 2002; số văn bằng: Jeonbukdae2001(seok)608; ngành: Khoa học và công nghệ Bán dẫn; chuyên ngành: Quang điện tử;

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc.

- Được cấp bằng TS ngày 22 tháng 08 năm 2006; số văn bằng: Jeonbukdae2005(bak)154; ngành: Khoa học và công nghệ Bán dẫn; chuyên ngành: Quang điện tử;

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc.

- Được cấp bằng TSKH ngày ... tháng ... năm ....; số văn bằng: .....; ngành: .....; chuyên ngành: .....; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): .....

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ..... tháng ..... năm ..... ,  
ngành: .....

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Đại học Nguyễn Tất Thành

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

+ Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang điện của cấu trúc đa chiều trên nền Graphene.

+ Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cấu trúc đa chiều

#### 14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) ..... NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (Hướng dẫn chính 03 HVCH và đồng hướng dẫn 01 HVCH);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: (số lượng) 02 đề tài cấp cơ sở Đại học Nguyễn Tất Thành;
- Đã công bố (số lượng) 86 bài báo KH, trong đó 15 bài báo KH trước khi được cấp bằng tiến sĩ và 71 bài sau khi được cấp bằng tiến sĩ;
- Đã được cấp (số lượng) 01 bằng độc quyền sáng chế;
- Số lượng sách đã xuất bản ....., trong đó ..... thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: .....
- H-index = 22 (Google Scholar 2021)

#### 15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): .....

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): Ứng viên không bị kỷ luật nào.

### **B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ**

#### **1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:**

- Đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe để đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
- Trong quá trình công tác, tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giảng viên theo qui định của Luật giáo dục đại học;
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học thông qua việc tham gia và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu các cấp, công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế;
- Không vi phạm qui chế, qui định nào trong quá trình công tác.

#### **2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (\*):**

- Tổng số 12 năm 07 tháng.
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2010-2011			01 ThS (Lê Thị Lua, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) (70 tiết)				0 / 70 / 270
...	.....							
2	2016-2017				02 Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM	135	90	250 / 407,76 / 81
3	2017-2018		01 NCS (Trần Quang Nguyên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) (17 tiết)	- Hướng dẫn chính 02 ThS (Đoàn Tuấn Anh và Võ Huỳnh Như Ý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) (140 tiết) - Đồng hướng dẫn 01 ThS (Trần Trung Tín, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) (35 tiết)		90		90 / 284,16 / 81
3 năm học cuối								
4	2018-2019		01 NCS (Trần Quang Nguyên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM)			180		180 / 274,4 / 216

			HCM) (17 tiết)				
5	2019-2020		01 NCS (Trần Quang Nguyên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) (17 tiết)			180	180 / 251 / 216
6	2020-2021		01 NCS (Trần Quang Nguyên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) (17 tiết)			45	45 / 81,35 / 27

(\*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

### 3. Ngoại ngữ:

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài:

- Học ĐH ; Tại nước: .....; Từ năm ..... đến năm .....

- Bảo vệ luận văn ThS  và luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: Hàn Quốc, năm 2002 (Thạc sĩ) và năm 2006 (Tiến sĩ).

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ..... số bằng: .....; năm cấp:.....

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:.....

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): .....

d) Đối tượng khác  ; Diễn giải: .....

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEIC-840

**4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng**

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Võ Huỳnh Như Ý (Theo quyết định công nhận tên đề tài số 2476/QĐ-KHTN ký ngày 29/12/2017)		HVCH	Chính		01/2018 – 08/2018	Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM	30/12/2019
2	Đoàn Tuấn Anh (Theo quyết định công nhận tên đề tài số 2476/QĐ-KHTN ký ngày 29/12/2017)		HVCH	Chính		01/2018 – 08/2018	Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM	30/12/2019
3	Trần Trung Tín (Theo quyết định công nhận tên đề tài số 2476/QĐ-KHTN ký ngày 29/12/2017)		HVCH		Phụ	01/2018 – 08/2018	Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM	08/05/2019
4	Lê Thị Lụa (Theo quyết định công nhận tên đề tài số 603-QĐ/KHTN-SĐH ký ngày 06/08/2011)		HVCH	Chính		05/2010 – 10/2011	Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM	20/06/2012
5	Trần Quang Nguyên (Theo quyết định công nhận tên đề tài số 1095-QĐ/KHTN-SĐH ký ngày 18/07/2017)	NCS			Phụ	Đang hướng dẫn	Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM	

**Ghi chú:** Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

### 5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
I	Trước khi được công nhận PGS/TS						
1							
II	Sau khi được công nhận PGS/TS						
1							

Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: [ ],.....

#### Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

### 6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ
I	Trước khi được cấp bằng TS				
1					
II	Sau khi được cấp bằng TS				
1	Chế tạo lớp đệm zinc oxide với cấu trúc hình mái vòm ứng dụng chống phản xạ tia cực tím	CN	- Số: 2019.01.26/HĐ-KHCN - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành	01/2019 - 10/2019	11/01/2020 Xếp loại: tốt
2	Thiết kế hệ đèn LEDs RGB phục vụ cho cây trồng	CN	- Số: 2021.01.120 /HĐ-KHCN - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành	01/2021 - 06/2021	17/5/2021 Xếp loại: Xuất sắc
3	Chế tạo cảm biến tia cực tím linh hoạt và trong suốt dựa trên phương pháp tổng hợp dung dịch	CN	- Số: 103.02-2018.352 - Quỹ Phát triển Khoa học & Công	04/2019 - 04/2021	Đang chờ nghiệm thu

			nghe Quốc gia Nafosted		
4	Nghiên cứu giải pháp, chế tạo vật liệu và thiết bị mới để phân hủy các hợp chất hữu cơ trong bảo quản rau quả sau thu hoạch	CN	- Số: 05/2020/TN - Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Quốc gia Nafosted	04/2020 - 03/2023	Đang thực hiện

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

### 7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

#### 7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
I	<i>Trước khi được cấp bằng TS</i>							
1	Influence of Ga source on nitrogen incorporation of Ga(In)AsN Quantum Wells Grown by Metalorganic Chemical Vapor Deposition	6	x	Journal of the Korean Physical Society ISSN:1976-8524	<b>2003:</b> ISI, Q3 IF = 1.275 H-Index 48	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = 0.56	1 42,551 4	2/2003
2	Composition dependence of the band-gap energy of GaAsN alloys	7		Journal of the Korean Physical Society ISSN:1976-8524 <a href="https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5711&amp;vmd=Full">https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5711&amp;vmd=Full</a>	<b>2003:</b> ISI, Q3 IF = 1.275 H-Index 48	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = 0.56	22 43,2,2 73	8/2003
3	Photocurrent and photoluminescence measurements on In <sub>0.2</sub> Ga <sub>0.8</sub> As <sub>0.98</sub> N <sub>0.02</sub> /GaAs strained multi-quantum wells grown by using metalorganic chemical vapor deposition	7		Journal of the Korean Physical Society ISSN:1976-8524 <a href="https://doi.org/10.3938/jkps.43.758">https://doi.org/10.3938/jkps.43.758</a>	<b>2003:</b> ISI, Q3 IF = 1.275 H-Index 48	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = 0.56	3 43,5,7 58	11/2003



4	Influence of Sb surfactant on the structural and optical properties of InGaAsN/GaAs multi quantum wells grown by metalorganic chemical vapor deposition	5		Physica Status Solidi C ISSN:1610-1642 <a href="https://doi.org/10.1002/pssc.200303556">https://doi.org/10.1002/pssc.200303556</a>	<b>2003:</b> ISI, Q3 IF = NA; H-Index 46	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = NA;	4	7,2761	11/2003
5	The influence of well and barrier conditions on InGaAsN/GaAs multiple quantum wells grown by using MOCVD	7		Journal of the Korean Physical Society ISSN:1976-8524 <a href="https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5871&amp;vmd=Full">https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5871&amp;vmd=Full</a>	<b>2003:</b> ISI, Q3 IF = 1.275 H-Index 48	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = 0.56	1	43,6,1096	12/2003
6	Photocurrent measurement on GaAs <sub>1-x</sub> N <sub>x</sub> epilayers grown by metalorganic chemical vapor deposition	7		Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.09.002">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.09.002</a>	<b>2004:</b> ISI, Q1 IF = 1.849 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 1.632	1	260,3,336	1/2004
7	Influence of Sb doping on In <sub>0.2</sub> Ga <sub>0.8</sub> As <sub>0.98</sub> N <sub>0.02</sub> /GaAs strained multi quantum wells grown by metalorganic chemical vapor deposition	7		Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.11.101">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.11.101</a>	<b>2004:</b> ISI, Q1 IF = 1.849 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 1.632	1	263,1,156	3/2004
8	Optical property of In <sub>0.2</sub> Ga <sub>0.8</sub> As/GaAs strained multiple quantum wells grown by using MOCVD	4		Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.05.012">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.05.012</a>	<b>2004:</b> ISI, Q1 IF = 1.849 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 1.632	5	268,1,59	7/2004
9	Influence of annealing and surfactant on InGaAsN/GaAs multiple quantum well	7		Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.04.016">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.04.016</a>	<b>2004:</b> ISI, Q1 IF = 1.849 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 1.632	5	267,3,412	7/2004

10	The tri-methyl-Sb flow and the surfactant time effect on InGaAsN/GaAs strained MQWs grown by MOCVD	6		Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.06.052">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.06.052</a>	<b>2004:</b> ISI, Q1 IF = 1.849 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 1.632	3	270,3,340	8/2004
11	Effect of interlayer on optical properties of InGaAsN/GaAs quantum well grown by metalorganic chemical vapor deposition	5	x	Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.07.077">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.07.077</a>	<b>2004:</b> ISI, Q1 IF = 1.849 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 1.632		271,3,348	9/2004
12	Suppression of cracks and V-shaped defects, and improvement of reflectivity of GaN/AlGaN distributed bragg reflectors by insertion of multiple interlayers	10		Physica Status Solidi (A) ISSN:1862-6300 <a href="https://doi.org/10.1002/pssa.200405117">https://doi.org/10.1002/pssa.200405117</a>	<b>2004:</b> ISI, Q2 IF = 0.912 H-Index 104	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 1.606	7	201,12,2799	9/2004
13	Calculation of the external quantum efficiency of light emitting diodes with different chip designs	3	x	Physica Status Solidi C ISSN:1610-1642 <a href="https://doi.org/10.1002/pssc.200405116">https://doi.org/10.1002/pssc.200405116</a>	2004: ISI, Q3 IF = NA H-Index 46	2021: ISI, Q4 IF = NA	10	1,10,2433	9/2004
14	Effect of annealing on InGaN/GaN multiple quantum wells	7		Journal of the Korean Physical Society ISSN:1976-8524 <a href="https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=7240&amp;vmd=Full">https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=7240&amp;vmd=Full</a>	<b>2005:</b> ISI, Q3 IF = 0.856 H-Index 48	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = 0.56	9	47,5,871	11/2005
15	Comparison of In <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> N/GaN MQWs grown on GaN and sapphire substrates	4		Journal of the Korean Physical Society ISSN:1976-8524 <a href="https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=8042&amp;vmd=Full">https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=8042&amp;vmd=Full</a>	<b>2006:</b> ISI, Q3 IF = 1.34 H-Index 48	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = 0.56	2	49,5,2001	11/2006

II	<i>Sau khi được cấp bằng TS</i>								
16	Structural and optical properties of near-UV LEDs grown on V-grooved sapphire substrates fabricated by wet etching	8		Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2006.11.037">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2006.11.037</a>	<b>2007:</b> ISI, Q1 IF = 1.82 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 1.632	12	298,699	1/2007
17	Enhanced light output from aligned micropit InGaN-based light emitting diodes using wet-etch sapphire patterning	8	x	Applied Physics Letters ISSN:0003-6951 <a href="https://doi.org/10.1063/1.2714203">https://doi.org/10.1063/1.2714203</a>	<b>2007:</b> ISI, Q1 IF = 3.994 H-Index 442	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.597	115	90,13,131107	3/2007
18	Strain-induced compositional fluctuation and V-defect formation in green InGaN/GaN multi-quantum wells grown on sapphire and freestanding GaN substrates	6	x	Japanese Journal of Applied Physics ISSN:0021-4922 <a href="https://doi.org/10.1143/JJAP.46.L372">https://doi.org/10.1143/JJAP.46.L372</a>	<b>2007:</b> ISI, Q1 IF = NA H-Index 67	<b>2021:</b> ISI IF = NA;	10	46,16,L372-L375	4/2007
19	Effect of periodic deflector embedded in InGaN/GaN light emitting diode	7		Applied Physics Letters ISSN:0003-6951 <a href="https://doi.org/10.1063/1.2752777">https://doi.org/10.1063/1.2752777</a>	<b>2007:</b> ISI, Q1 IF = 3.994 H-Index 442	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.597	39	90,26,261117	6/2007
20	Fabrication of mesa-shaped InGaN/GaN light emitting diode with periodic deflectors by selective metal organic chemical vapor deposition	7		Japanese Journal of Applied Physics ISSN:0021-4922 <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.46.L970">https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.46.L970</a>	<b>2007:</b> ISI, Q1 IF = NA H-Index 67	<b>2021:</b> ISI IF = NA;	1	46,10L,L970	10/2007
21	Spatial distribution of crown shaped light emission from a periodic inverted polygonal deflector embedded in an InGaN/GaN light emitting diode	10		Applied Physics Letters ISSN:0003-6951 <a href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApPhL..92f1118K/abstract">https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApPhL..92f1118K/abstract</a>	<b>2008:</b> ISI, Q1 IF = 3.957 H-Index 442	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.597	10	92,6,061118	2/2008

22	InGaN/GaN light emitting diode with R-plane polygonal facet deflectors	7		Physica Status Solidi C ISSN:1610-1642 <a href="https://doi.org/10.1002/pssc.200778674">https://doi.org/10.1002/pssc.200778674</a>	<b>2008:</b> ISI, Q3 IF = NA H-Index 46	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = NA		5,6,22 67	4/2008
23	Growth of periodic micropits InGaN-based LED structure on wet-etch patterned sapphire substrate	11		Physica Status Solidi C ISSN:1610-1642 <a href="https://doi.org/10.1002/pssc.200778675">https://doi.org/10.1002/pssc.200778675</a>	<b>2008:</b> ISI, Q3 IF = NA H-Index 46	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = NA	1	5,6,20 01	4/2008
24	Characterization of plasma damage-free InGaN/GaN LED with periodic deflectors	7	x	Physica Status Solidi C ISSN:1610-1642 <a href="https://doi.org/10.1002/pssc.200778498">https://doi.org/10.1002/pssc.200778498</a>	<b>2008:</b> ISI, Q3 IF = NA H-Index 46	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = NA		5,6,21 55	4/2008
25	Improved GaN-based LED light extraction efficiencies via selective MOCVD using peripheral microhole arrays	7		IEEE Photonics Technology Letters ISSN:1041-1135 <a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/4563481">https://ieeexplore.ieee.org/document/4563481</a>	<b>2008:</b> ISI, Q1 IF = 2.961 H-Index 157	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF = 2.451	16	20,15, 1284	8/2008
26	Improved thermal stability of green InGaN/GaN multiple-quantum well light emitting diodes with an AlGaIn/GaN short superlattice inserted structure	8		Journal of the Korean Physical Society ISSN:1976-8524 <a href="https://doi.org/10.3938/jkps.54.140">https://doi.org/10.3938/jkps.54.140</a>	<b>2009:</b> ISI, Q2 IF = 0.925 H-Index 48	<b>2021:</b> ISI, Q4 IF = 0.56	3	54,1,1 40	1/2009
27	A simple hydrothermal preparation of TiO <sub>2</sub> nanomaterials using concentrated hydrochloric acid	6		Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.09.032">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.09.032</a>	<b>2009:</b> ISI, Q1 IF = 1.709 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 1.632	66	312,1, 79	12/2009
28	Optoelectronic properties of graphene thin films	7	x	Materials Letter	<b>2010:</b>	<b>2021:</b>	56	64,6,7 65	1/2010

	prepared by thermal reduction of graphene oxide			ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.01.009">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.01.009</a>	ISI, Q1 IF = 2.438 H-Index 144	ISI, Q1 IF= 3.204			
29	Fast and simple fabrication of a large transparent chemically-converted graphene film by spray-coating	7		Carbon ISSN:0008-6223 <a href="https://doi.org/10.1016/j.carbon.2010.01.062">https://doi.org/10.1016/j.carbon.2010.01.062</a>	<b>2010:</b> ISI, Q1 IF = 6.084 H-Index 279	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 8.821	336	48,7,1 945	2/2010
30	Fabrication of TiO <sub>2</sub> nanostructured films by spray deposition with high photocatalytic activity of methylene blue	8		Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.03.033">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.03.033</a>	<b>2010:</b> ISI, Q1 IF = 2.438 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204	38	64,12, 1387	3/2010
31	One-step synthesis of superior dispersion of chemically converted graphene in organic solvents	9		Chemical Communications ISSN: 1359-7345 <a href="https://doi.org/10.1039/C0CC00363H">https://doi.org/10.1039/C0CC00363H</a>	<b>2010:</b> ISI, Q1 IF = 5.77 H-Index 333	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 5.996	161	46,24, 4375	5/2010
32	Solution-processed ZnO-chemically converted graphene gas sensor	11	x	Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.08.027">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.08.027</a>	<b>2010:</b> ISI, Q1 IF = 2.438 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204	143	64,22, 2479	8/2010
33	Photoluminescence and Raman studies of graphene thin films prepared by reduction of graphene oxide	7	x	Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.11.029">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.11.029</a>	<b>2010:</b> ISI, Q1 IF = 2.438 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204	207	64,3,3 99	11/2010
34	Chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of a graphene oxide suspension in N-methyl-2-pyrrolidone	7		Journal of Materials Chemistry ISSN:1364-5501	<b>2010:</b> ISI, Q1 IF = 5.465 H-Index 301	<b>2021:</b> ISI IF = NA	367	21,10, 3371	12/2010

				<a href="https://doi.org/10.1039/C0JM02790A">https://doi.org/10.1039/C0JM02790A</a>					
35	Solution-processed semitransparent p-n graphene oxide CNT/ZnO heterojunction diodes for visible-blind UV sensors	11	x	Physica Status Solidi (A) ISSN:1862-6300 <a href="https://doi.org/10.1002/pssa.201026553">https://doi.org/10.1002/pssa.201026553</a>	<b>2011:</b> ISI, Q1 IF=1.709 H-Index 104	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF=1.606	21	208,4,943	1/2011
36	Superior conductive polystyrene-chemically converted graphene nanocomposite	8		Journal of Materials Chemistry ISSN:1364-5501 <a href="https://doi.org/10.1039/C1JM11146A">https://doi.org/10.1039/C1JM11146A</a>	<b>2011:</b> ISI, Q1 IF = 6.372 H-Index 301	<b>2021:</b> ISI IF = NA	88	21,30,11312	6/2011
37	Graphene network on indium tin oxide nanodot nodes for transparent and current spreading electrode in InGaN/GaN light emitting diode	13		Applied Physics Letters ISSN:0003-6951 <a href="https://doi.org/10.1063/1.3601462">https://doi.org/10.1063/1.3601462</a>	<b>2011:</b> ISI, Q1 IF = 4.387 H-Index 442	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.597	50	98,25,251114	6/2011
38	Synthesis of the chemically converted graphene xerogel with superior electrical conductivity	7		Chemical Communications ISSN: 1359-7345 <a href="https://doi.org/10.1039/C1CC13329B">https://doi.org/10.1039/C1CC13329B</a>	<b>2011:</b> ISI, Q1 IF = 6.418 H-Index 333	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 5.996	147	47,34,9672	7/2011
39	Low-voltage solution-processed graphene transistors based on chemically and solvothermally reduced graphene oxide	8		Journal of Materials Chemistry ISSN:1364-5501 <a href="https://doi.org/10.1039/C1JM11691F">https://doi.org/10.1039/C1JM11691F</a>	<b>2011:</b> ISI, Q1 IF = 6.372 H-Index 301	<b>2021:</b> ISI IF = NA	27	21,34,13068	7/2011
40	Temperature-dependent photoluminescence from chemically and thermally reduced graphene oxide	9	x	Applied Physics Letters ISSN:0003-6951	<b>2011:</b> ISI, Q1 IF = 4.387	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.597	51	99,4,041905	7/2011

				<a href="https://doi.org/10.1063/1.3616142">https://doi.org/10.1063/1.3616142</a>	H-Index 442				
41	Enhanced light output power of near UV light emitting diodes with graphene/indium tin oxide nanodot nodes for transparent and current spreading electrode	12		Optics Express ISSN:1094-4087 <a href="https://doi.org/10.1364/OE.19.023111">https://doi.org/10.1364/OE.19.023111</a>	<b>2011:</b> ISI, Q1 IF = 4.598 H-Index 271	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.669	44	19,23, 23111	10/2011
42	Enhanced photocatalytic activity of graphene oxide decorated TiO2 films under UV and visible irradiation	7		Current Applied Physics ISSN:1567-1739 <a href="https://doi.org/10.1016/j.cap.2010.11.077">https://doi.org/10.1016/j.cap.2010.11.077</a>	<b>2011:</b> ISI, Q1 IF = 2.205 H-Index 86	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 2.281	115	11,3,8 05	12/2011
43	Synthesis of highly concentrated suspension of chemically converted graphene in organic solvents: effect of temperature on the extent of reduction and dispersibility	7		Korean Journal of Chemical Engineering ISSN:0256-1115 <a href="https://doi.org/10.1007/s11814-011-0232-0">https://doi.org/10.1007/s11814-011-0232-0</a>	<b>2012:</b> ISI, Q2 IF = 1.227 H-Index 60	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 2.69	29	29,5,6 80	1/2012
44	Photocatalytic performance of a Ag/ZnO/CCG multidimensional heterostructure prepared by a solution-based method	7		Journal of Physical Chemistry C ISSN:1932-7455 <a href="https://doi.org/10.1021/jp210216w">https://doi.org/10.1021/jp210216w</a>	<b>2012:</b> ISI, Q1 IF = 5.141 H-Index 289	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 4.189	98	116,12 ,7180	3/2012
45	Novel conductive epoxy composites composed of 2-D chemically reduced graphene and 1-D silver nanowire hybrid fillers	6		Journal of Materials Chemistry ISSN:1364-5501 <a href="https://doi.org/10.1039/C2JM16910J">https://doi.org/10.1039/C2JM16910J</a>	<b>2012:</b> ISI, Q1 IF = 6.491 H-Index 301	<b>2021:</b> ISI IF = NA	97	22,17, 8649	3/2012
46	Controlled growth of ZnO nanomaterials via hydrothermal method effect of buffer layer	7	x	Journal of Nanoscience and Nanotechnology ISSN:1533-4880	<b>2012:</b> ISI, Q2 IF = 1.348 H-Index 105	<b>2021:</b> ISI IF= 1.134	8	12,4,3 313	4/2012

				<a href="https://doi.org/10.1166/jnn.2012.5592">https://doi.org/10.1166/jnn.2012.5592</a>					
47	Fast and simple reduction of graphene oxide in various organic solvents using microwave irradiation	7		Journal of Nanoscience and Nanotechnology ISSN:1533-4880 <a href="https://doi.org/10.1166/jnn.2012.6340">https://doi.org/10.1166/jnn.2012.6340</a>	<b>2012:</b> ISI, Q2 IF = 1.348 H-Index 105	<b>2021:</b> ISI IF= 1.134	21	12,7,5 658	7/2012
48	Improved heat dissipation in gallium nitride light-emitting diodes with embedded graphene oxide pattern	15	x	Nature Communication ISSN:2041-1723 <a href="https://doi.org/10.1038/ncomms2448">https://doi.org/10.1038/ncomms2448</a>	<b>2013:</b> ISI, Q1 IF = 12.243 H-Index 365	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF = 12.121	170	4,1,1	2/2013
49	Transport and magnetic properties of Bi <sub>2</sub> Fe <sub>4</sub> O <sub>9</sub> -Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> nanocomposite films grown on LaAlO <sub>3</sub> (100) substrates by molecular beam epitaxy	4		Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.03.008">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.03.008</a>	<b>2013:</b> ISI, Q1 IF = 2.504 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204		100,17 7	3/2013
50	Enhanced light extraction efficiency of GaN-based LED with ZnO nanorod grown on Ga-doped ZnO seed layer	8		ECS Solid State Letters ISSN:2162-8750 <a href="https://doi.org/10.1149/2.005306ssl">https://doi.org/10.1149/2.005306ssl</a>	<b>2013:</b> ISI, Q3 IF = 1.11 H-Index 21	<b>2021:</b> ISI IF = NA	12	2,6,Q4 3	3/2013
51	Formation and ferromagnetic properties of FeSi thin films	5		Journal of Applied Physics ISSN:1089-7550 <a href="https://doi.org/10.1063/1.4800839">https://doi.org/10.1063/1.4800839</a>	<b>2013:</b> ISI, Q1 IF = 2.416 H-Index 319	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 2.286	8	113,17 ,17C3 06	4/2013
52	Stimulated N-doping of reduced graphene oxide on GaN under excimer laser reduction process	9		Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.11.072">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.11.072</a>	<b>2013:</b> ISI, Q1 IF = 2.504 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204	12	116,41 2	11/2013



53	Reduced graphene oxide as an over-coating layer on silver nanostructures for detecting NH <sub>3</sub> gas at room temperature	7	x	Sensors and Actuators B: Chemical ISSN:0925-4005 <a href="https://doi.org/10.1016/j.snb.2013.12.062">https://doi.org/10.1016/j.snb.2013.12.062</a>	<b>2013:</b> ISI, Q1 IF = 4.257 H-Index 197	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF = 7.1	81	194,45	12/2013
54	Size dependence of silica nanospheres embedded in 385 nm ultraviolet light-emitting diodes on a far-field emission pattern	9		Optics Express ISSN:1094-4087 <a href="https://doi.org/10.1364/OE.22.0A1553">https://doi.org/10.1364/OE.22.0A1553</a>	<b>2014:</b> ISI, Q1 IF = 4.645 H-Index 271	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.669		22,S6, A1553	1/2014
55	Zirconium nitride polycrystalline films grown on Si (111) substrates by metal organic chemical vapor deposition	5		Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.03.112">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.03.112</a>	<b>2014:</b> ISI, Q1 IF = 2.789 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204	3	125,1, 8	3/2014
56	Threading dislocation reduction in epitaxial GaN using V-groove patterned sapphire substrate with embedded silica nanospheres	9		Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.02.091">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.02.091</a>	<b>2014:</b> ISI, Q1 IF = 2.789 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204	6	123,1, 97	3/2014
57	Influence of Ga content on the structure and anomalous hall effect of Fe <sub>1-x</sub> Ga <sub>x</sub> thin films on GaSb(100)	5		Journal of Applied Physics ISSN:1089-7550 <a href="https://doi.org/10.1063/1.4869063">https://doi.org/10.1063/1.4869063</a>	<b>2014:</b> ISI, Q1 IF = 2.409 H-Index 139	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 2.286	6	115,17, 17C7 42	4/2014
58	Enhanced optical output power by the silver localized surface plasmon coupling through side facets of micro-hole patterned InGaN/GaN light-emitting diodes	10		Optics Express ISSN:1094-4087 <a href="https://doi.org/10.1364/OE.22.0A1051">https://doi.org/10.1364/OE.22.0A1051</a>	<b>2014:</b> ISI, Q1 IF = 4.645 H-Index 271	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.669	5	22,S4, A1051	5/2014
59	Effect of copper oxide on the resistive switching responses of graphene oxide film	3		Current Applied Physics ISSN:1567-1739	<b>2014:</b> ISI, Q1 IF = 2.749	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 2.281	11	14,9,1 301	7/2014

				<a href="https://doi.org/10.1016/j.cap.2014.07.005">https://doi.org/10.1016/j.cap.2014.07.005</a>	H-Index 86				
60	Unraveling oxygen transfer at the graphene-oxide-ZnO nanorod interface	7	x	Journal of Physical Chemistry C ISSN:1932-7455 <a href="https://doi.org/10.1021/jp5039046">https://doi.org/10.1021/jp5039046</a>	<b>2014:</b> ISI, Q1 IF = 5.119 H-Index 289	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 4.189	20	118,31,17638	7/2014
61	Fabrication and characteristics of GaN-based light-emitting diodes with a reduced graphene oxide current-spreading layer	11		ACS applied materials & interfaces ISSN:1944-8244 <a href="https://doi.org/10.1021/am506308t">https://doi.org/10.1021/am506308t</a>	<b>2014:</b> ISI, Q1 IF = 7.145 H-Index 228	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 8.758	13	6,24,22451	11/2014
62	Solution-processed multidimensional ZnO/CuO heterojunction as ultraviolet sensing	6		Optical Materials Express ISSN:2159-3930 <a href="https://doi.org/10.1364/OME.5.001752">https://doi.org/10.1364/OME.5.001752</a>	<b>2015:</b> ISI, Q1 IF = 3.087 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.064	13	5,8,1752	6/2015
63	Reduced junction temperature and enhanced performance of high power light-emitting diodes using reduced graphene oxide pattern	10		Journal of Physics D: Applied Physics ISSN:1361-6463 <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/48/26/265102">https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/48/26/265102</a>	<b>2015:</b> ISI, Q1 IF = 3.17 H-Index 198	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.169	8	48,26,265102	6/2015
64	Significant reduction of AlN wafer bowing grown on sapphire substrate with patterned graphene oxide	6	x	Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.07.162">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2015.07.162</a>	<b>2015:</b> ISI, Q1 IF = 2.641 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204		160,1,496	7/2015
65	Effect of characteristic properties of graphene oxide on reduced graphene oxide/Si	8		Materials Science in	<b>2016:</b> ISI, Q1	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.085	10	44,1,1	3/2016

	schottky diodes performance			Semiconductor Processing ISSN:1369-8001 <a href="https://doi.org/10.1016/j.mssp.2015.12.022">https://doi.org/10.1016/j.mssp.2015.12.022</a>	IF = 2.513 H-Index 60				
66	Nanostructural effect of ZnO on light extraction efficiency of near-ultraviolet light-emitting diodes	6	x	Journal of Nanomaterials ISSN: 1687-4110 <a href="https://doi.org/10.1155/2016/7947623">https://doi.org/10.1155/2016/7947623</a>	<b>2016:</b> ISI, Q2 IF = 1.241 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 1.98	18	2016,7947623	3/2016
67	Long-term stability of Si-organic hybrid solar cells with a thermally tunable graphene oxide platform	9		RSC advances ISSN:2046-2069 <a href="https://doi.org/10.1039/C6RA12441K">https://doi.org/10.1039/C6RA12441K</a>	<b>2016:</b> ISI, Q1 IF = 3.233 H-Index 148	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.119	6	6,7,72342	7/2016
68	Nanostructured Optoelectronics: Materials and Devices	4		Journal of Nanomaterials ISSN: 1687-4110 <a href="https://doi.org/10.1155/2016/2051908">https://doi.org/10.1155/2016/2051908</a>	<b>2016:</b> ISI, Q2 IF = 1.241 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 1.98	3	2016,2051908	8/2016
69	Transparent and flexible ultraviolet photoconductors based on solution-processed graphene quantum dots on reduced graphene oxide films	6	x	Material Research Bulletin ISSN: 0025-5408 <a href="https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.03.033">https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.03.033</a>	<b>2017:</b> ISI, Q1 IF = 3.041 H-Index 110	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 4.019	13	91,49	3/2017
70	Enhanced thermal stability of reduced graphene oxide-Silicon schottky heterojunction solar cells via nitrogen doping	9		Materials Science in Semiconductor Processing ISSN:1369-8001	<b>2017:</b> ISI, Q1 IF = 2.769 H-Index 60	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.085	9	59,1,45	3/2017

				<a href="https://doi.org/10.1016/j.mssp.2016.11.021">https://doi.org/10.1016/j.mssp.2016.11.021</a>					
71	Hexagonal boron nitride pattern embedded in AlN template layer for visible-blind ultraviolet photodetectors	7		Optical Materials Express ISSN:2159-3930 <a href="https://doi.org/10.1364/OME.7.01463">https://doi.org/10.1364/OME.7.01463</a>	<b>2017:</b> ISI, Q1 IF = 2.788 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.064	5	7,5,14 63	4/2017
72	Characterization of Ag-doped p-type SnO thin films prepared by DC magnetron sputtering	7	x	Journal of Nanomaterials ISSN: 1687-4110 <a href="https://doi.org/10.1155/2017/8360823">https://doi.org/10.1155/2017/8360823</a>	<b>2017:</b> ISI, Q2 IF = 1.34 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 1.98	9	2017,8 36082 3	11/2017
73	Carrier transport mechanism of Al contacts on n-type 4H-SiC	10		Materials Letter ISSN:0167-577X <a href="https://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.05.119">https://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.05.119</a>	<b>2018:</b> ISI, Q1 IF = 3.252 H-Index 144	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 3.204	3	228,1, 232	5/2018
74	The facile synthesis of novel ZnO nanostructure for galactose biosensor application	6	x	Journal of Nanomaterials ISSN: 1687-4110 <a href="https://doi.org/10.1155/2019/2364327">https://doi.org/10.1155/2019/2364327</a>	<b>2019:</b> ISI, Q2 IF = 1.915 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 1.98	3	2019,2 36432 7	2/2019
75	Characteristics of aluminum nitride films on hexagonal boron nitride buffer layers using various growth methods through metal organic chemical vapor deposition	8		Journal of Crystal Growth ISSN: 0022-0248 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.09.018">https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.09.018</a>	<b>2019:</b> ISI, Q2 IF = 1.759 H-Index 149	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF= 1.632	1	507,1, 316	2/2019
76	Reduced thermal resistance of heat sink using graphene oxide decorated with copper nanoparticles	13		Material Research Bulletin ISSN: 0025-5408	<b>2019:</b> ISI, Q1 IF = 4.147 H-Index 110	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 4.019	4	110,76	2/2019

				<a href="https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2018.06.028">https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2018.06.028</a>					
77	Multidimensional graphene and ZnO-based heterostructure for flexible transparent ultraviolet photodetector	6	x	Applied Surface Science ISSN: 0169-4332 <a href="https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.03.163">https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.03.163</a>	<b>2019:</b> ISI, Q1 IF = 6.386 H-Index 188	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 6.182	16	481, 1, 524	3/2019
78	Ohmic contact mechanism for Ni/C-faced 4H-n-SiC substrate	12		Journal of Nanomaterials ISSN: 1687-4110 <a href="https://doi.org/10.1155/2019/5231983">https://doi.org/10.1155/2019/5231983</a>	<b>2019:</b> ISI, Q2 IF = 1.915 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 1.98		2019,5 23198 3	12/2019
79	Inserting dome shape microstructure for enhancement of ultraviolet photodetector performance of n-ZnO nanorods/p-Si heterojunction	6	x	Journal of Alloys and Compounds ISSN: 0925-8388 <a href="https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.153884">https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.153884</a>	<b>2020:</b> ISI, Q1 IF = 4.65 H-Index 172	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF = 4.65	4	823,15 ,15388 4	1/2020
80	Solution processed graphene quantum dots decorated ZnO nanoflower for mediating photoluminescence	7	x	Applied Surface Science ISSN: 0169-4332 <a href="https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.145407">https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.145407</a>	<b>2020:</b> ISI, Q1 IF = 6.707 H-Index 188	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 6.182	2	510, 30, 14540 7	1/2020
81	Gallium dopant-induced tunable electrical properties of reduced graphene oxide using metal organic chemical vapor deposition	7		Applied Surface Science ISSN: 0169-4332 <a href="https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.144500">https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.144500</a>	<b>2020:</b> ISI, Q1 IF = 6.707 H-Index 188	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF= 6.182	2	504, 28, 14450 0	2/2020
82	Effect of dissolved oxygen and oxygen	3		Journal of Semiconductor	<b>2020:</b>	<b>2021:</b>		20,1,7 6	2/2020

	scavenger on the etch rate of polysilicon			Technology and Science ISSN:1598-1657 <a href="http://doi.org/10.5573/JSTS.2020.20.1.076">http://doi.org/10.5573/JSTS.2020.20.1.076</a>	ISI, Q4 IF = 0.3 H-Index 19	ISI, Q4 IF = 0.3			
83	Ammonia gas sensing behavior of hybridization between reduced graphene oxide and gold nanoparticles	8	x	Journal of Nanomaterials ISSN: 1687-4110 <a href="https://doi.org/10.1155/2020/7680508">https://doi.org/10.1155/2020/7680508</a>	<b>2020:</b> ISI, Q2 IF = 2.44 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 1.98		2020, 68050 8	8/2020
84	Synthesis and photocatalytic activity of $\beta$ -Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> nanostructures for decomposition of formaldehyde under deep ultraviolet irradiation	12	x	Catalysts ISSN: 2073-4344 <a href="https://doi.org/10.3390/catal10101105">https://doi.org/10.3390/catal10101105</a>	<b>2020:</b> ISI, Q2 IF = 4.146 H-Index 53	<b>2021:</b> ISI, Q2 IF = 3.52	1	10,10, 1105	9/2020
85	Application of a ZnO nanorod layer to display retarder: dependence of the optical property on synthesis conditions	7		Optical Materials Express ISSN:2159-3930 <a href="https://doi.org/10.1364/OME.408412">https://doi.org/10.1364/OME.408412</a>	<b>2020:</b> ISI, Q1 IF = 3.064 H-Index 66	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF = 3.064		10,112, 3315	12/2020
86	Defect free MoS <sub>2</sub> flakes amorphous carbon hybrid as an advanced anode for lithium ion batteries	7		Energy & Fuels ISSN: 0887-0624 <a href="https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03896">https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03896</a>	<b>2021:</b> ISI, Q1 IF = 3.421 H-Index 186			35,4,3 459	1/2021

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 22 bài; thứ tự: 17, 18, 24, 28, 32, 33, 35, 40, 46, 48, 53, 60, 64, 66, 69, 72, 74, 77, 79, 80, 83, 84.

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc ký hiệu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
I	Trước khi được công nhận PGS/TS						

1							
II	Sau khi được công nhận PGS/TS						
1							

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: .....

### 7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/đồng tác giả	Số tác giả
1	Phân tử bán dẫn cho cảm biến tia UV; No. 10-1848011	Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc	29/04/2016	Đồng tác giả	3

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): 01 bằng độc quyền sáng chế, số TT 01

### 7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
1					
...					

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): .....

### 8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi chú
1						
...						

**9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế\*:**

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): .....

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): .....

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): năm học 2010-2011/200 giờ;

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): .....

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

.....

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: .....

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

.....

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

.....

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH  ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: .....

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: .....

*Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.*

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)



- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: .....
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: .....

**C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:**

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021*

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

***Trần Việt Cường***